

您半导体工艺控制的 合作伙伴



蔡司OEM光谱仪

我们与您携手合作，利用蔡司久经考验的技术和专业
知识，开发出出色的OEM光谱学解决方案



www.zeiss.com/spectrometer-modules

Seeing beyond

我们的技术为您提供解决方案

将蔡司光谱仪用于工艺流程控制, 您将在开发OEM解决方案时尽享优势。充分利用久经考验的蔡司技术, 可完全根据您的需求量身定制。

蔡司作为OEM供应商在半导体行业的应用



蚀刻工艺控制

蔡司光谱仪非常适合通过光学发射光谱法 (OES)、椭圆偏振技术或光谱反射法对蚀刻流程进行终点检测和厚度监测。



CMP工艺控制

蔡司开发定制的光谱仪解决方案, 可以通过高精度膜厚测量来实现化学机械抛光(CMP)工艺监测。



关键尺寸 (CD) 测量

蔡司光谱仪可以通过光学散射测量法 (OCD) 对晶圆上模结构的CD变化进行测量。

蔡司光谱仪的优势助您成功

- 积分时间短, 晶圆通量高
- 可快速扩展, 用于大批量生产
- 设备台间差小
- 长期稳定, 易于校准
- 提供定制光谱仪服务, 可选择蔡司像差校正光栅和各种探测器或狭缝尺寸



联系我们, 开始对话

MCS-PDA

波长范围	190–1015 nm
光学输入	SMA*
数值孔径	0.22
光谱像素间距	0.8 nm
杂散光	< 0.1 % (340 nm处)
探测器	S 3904-1024Q (1024 px)*
信噪比 (SNR)	> 12,000
动态范围 (DNR)	> 23,000
积分时间	> 1.1 ms

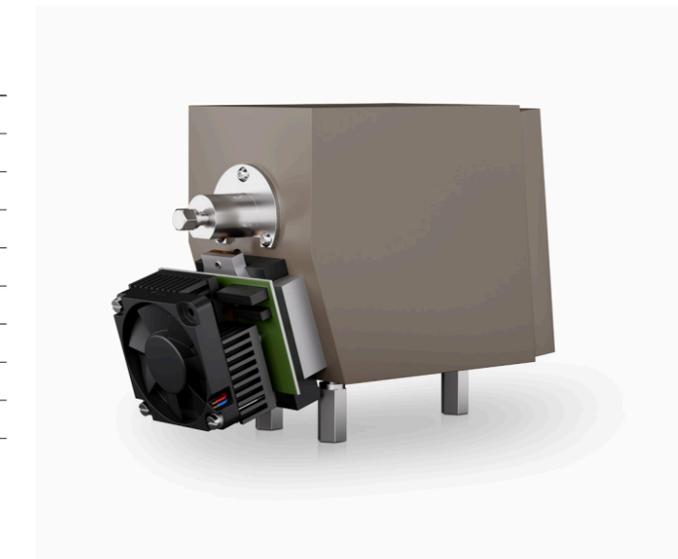
*其他可按需提供



MCS-CCD

波长范围	190–980 nm
光学输入	SMA*
数值孔径	0.22
光谱像素间距	0.8 nm
杂散光	< 0.1 % (340 nm处)
探测器	S 7031-1006 (1044 x 64 px)*
信噪比 (SNR)	> 1,000
动态范围 (DNR)	> 32,000
积分时间	> 3 ms

*其他可按需提供



CGS-CCD

波长范围	190–1015 nm
光学输入	SMA*
数值孔径	0.22
光谱像素间距	0.4 nm
杂散光	< 0.1 % (240 nm处)
探测器	S 11156 (2048 px)*
信噪比 (SNR)	> 500
动态范围 (DNR)	> 8,600
积分时间	> 0.1 ms

*其他可按需提供



Carl Zeiss Spectroscopy GmbH

Carl-Zeiss-Promenade 10
07745 Jena

Phone : + 49 3641 64-2838
Telefax : + 49 3641 64-2485
E-Mail: info.spectroscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/spectroscopy

卡尔蔡司 (上海) 管理有限公司

地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区美约路
60号 (200131)

电话: +86 21 2082 1306
传真: +86 21 5048 1193
邮箱: info.spectroscopy.cn@zeiss.com